

電力用半導体素子の特徴

	構造	方向性	スイッチング機能	位相制御	自己消弧能力 (自分でターンオフ できる能力)
①ダイオード	pn	1	×	×	×
②サイリスタ	pnpn	1	○	○	×
③GTO	pnpn	1	○	○	○
④トライアック	nnpn	2	○	○	×
⑤トランジスタ	pnp,npn	1	○ 低速	×	○
⑥IGBT	pnpn	1	○ やや高速	×	○
⑦FET	pnp,npn	1	○ 高速	×	○